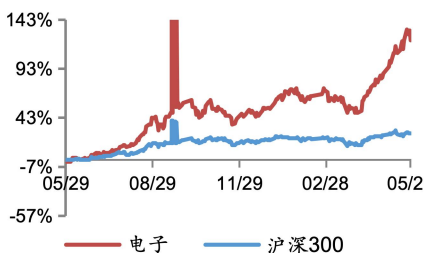


核心新股周巡礼系列 13-合肥长鑫科技招股书梳理

行业评级：增持

报告日期：2026-06-02

公司价格与沪深 300 走势比较



分析师：李美贤

执业证书号：S0010524020002

邮箱：limeixian@hazq.com

分析师：李元晨

执业证书号：S0010524070001

邮箱：liyc@hazq.com

相关报告

1. 核心新股周巡礼系列 12-泰金新能招股书梳理 2026/04/01
2. 核心新股周巡礼系列 11-联讯仪器招股书梳理 2026/03/10
3. 核心新股周巡礼系列 10-恒运昌招股书梳理 2025/02/09
4. 核心新股周巡礼系列 9-盛合晶微招股书梳理 2025/11/03
5. 核心新股周巡礼系列 7-臻宝科技招股书梳理 2025/08/16
6. 核心新股周巡礼系列 5-强一半导体招股书梳理 2025/08/04
7. 核心新股周巡礼系列 3-兆芯招股书梳理 2025/07/20
8. 科创招股书梳理之摩尔线程篇 2025/07/14
9. 科创招股书梳理之沐曦篇 2025/07/07

主要观点：

- 合肥国资是长鑫科技早期成长及长期发展的关键投资人，助力长鑫科技成为我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM IDM 公司

长鑫科技于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 等产品覆盖和迭代升级，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。长鑫科技目前是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM IDM 公司。

合肥国资为长鑫科技初期的巨额资金需求提供了保障，在企业经历亏损期时给予了坚定的战略定力。根据合肥发改委官方微信公众号文章显示，股权结构方面，发行前，长鑫科技第一大股东为清辉集电，持股比例为 21.67%。清辉集电第二大合伙人（持有清辉集电 48.9%）长鑫集成实控人为合肥市国资委，由合肥产投 100% 持股。另外，清辉集电第一大合伙人芯睿投资（持有清辉集电 51.09%）股权穿透后发现，其实控人为合肥经开区国资委。此外，安徽省投（实控人为安徽省国资委）对长鑫科技直接持股 7.91%。

- DRAM 是全球半导体市场占比最高且增速最高的单一品类之一，DRAM 产值受 AI 驱动，DRAM 涨价趋势有望延续至 2027 年

根据 Omdia 和 WSTS 数据，DRAM 是市场规模最大的存储芯片，2025 年全球 DRAM 市场规模为 1,505 亿美元，占存储芯片市场规模的比例约为 65%。

根据 TrendForce 最新数据预测，受 Agentic AI 驱动，全球 DRAM 产值 2026 年上调至 6187 亿美元，同比增长 303%；2027 年预计达 9033 亿美元，增长 46%。AI 服务器 CPU 与 GPU 配比升至 1:2 (NVIDIA NVL72 机架)，推高 DRAM 采购量及合约价；HBM 扩产挤压通用 DRAM 产能，厂商议价能力增强，DRAM 涨价趋势有望持续至 2027 年。

- 长鑫科技充分受益于人工智能带来的量价齐升，服务器收入占比快速提升，长鑫毛利率比肩三星电子综合毛利率

市场占有率方面，根据 Counterpoint 的数据统计显示，长鑫科技充分受益于人工智能的增长，实现量价齐升，2026 年长鑫存储一季度 DRAM 销售收入达 73.09 亿美元，环比增长 115.1%，同比增长超过 700%，巩固了其作为第四大供应商的地位，市场份额翻倍以上增长，达到 8%。服务器领域，长鑫科技的产品收入和占比快速增长，2024 年和 2025 年 1-6 月，实现营业收入 19.3 亿元和 35.2 亿元，占 DDR、LPDDR 产品合计收入的比例分别为 8.39% 和 23.72%，主要受益于数据中心等基础设施建设需求持续快速增长。公司与阿里云、字节跳动、腾讯、联想等行业核心客户开展了深度合作，持续赢得客户的肯定和赞誉。

毛利率方面，2025 年，得益于 DRAM 产品价格大幅上涨，长鑫科技公司综合毛利率已转正并大幅提升，与三星电子综合毛利率基本相当。

● **长鑫募资投入扩产和研发，聚焦先进 DRAM 产品技术升级改造**

存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目投入 75 亿元，计划于 2027 年底前分批实施厂务改造、机台搬入、机台调试、机台投产等工作，于 2028 年上半年前完成竣工验收。其中主要投入为设备购置及安装费，投入金额 46.66 亿，占比 62.22%。

DRAM 存储器技术升级项目投入 130 亿元，计划于 2026 年到 2027 年底前分批实施设备搬入、设备调试等工作，于 2028 年上半年前完成竣工验收。其中主要投入为设备购置及安装费，投入 174 亿，占比 96.67%。

动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目投入 90 亿元，计划于 2026 年 12 月前，完成引入新机台的调试，实现适配 DRAM 的前瞻技术平台的工艺流程搭建工作；2027 年 12 月前，完成前瞻技术平台工艺平台与工艺开发的结构搭建与验证，并进行技术平台工艺流程的优化工作；2028 年 12 月前，完成前瞻技术平台工艺与架构的完善，验证并提取出器件的关键电学特性工作。其中主要投入包括研发人员费用、固定资产投资、材料与备件及其他费用、测试与服务等。

● **风险提示**

存储扩产进度不及预期，客户验证进度不及预期，AI 服务器发展不及预期，产品研发和技术验证不及预期，市场竞争加剧；本报告新股介绍内容不涉及证券投资研究，仅为材料梳理以供投资者方便获取信息。

正文目录

1 长鑫科技：我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM IDM 企业	5
1.1 历经十载发展风雨兼程，长鑫科技实现 DRAM（包括 HBM 和普通 DRAM）市场份额中国第一，全球第四	5
1.2 公司产品覆盖 DDR、LPDDR 两大主流系列，提供当前市场主流的第四代、第五代产品	6
1.3 2023 年-2025 年长鑫科技产品呈现销量、单价和毛利率快速上升趋势，公司主力产品与竞争对手相当	8
1.4 公司拥有核心技术，产品受到头部客户认可	10
2 DRAM 是人工智能算力系统的核心枢纽，随基础设施投资而增长	11
2.1 DRAM 是全球半导体市场占比最高且增速最高的单一品类之一	11
2.2 服务器、移动设备、个人电脑和智能汽车构成 DRAM 主要应用领域，服务器复合增速最快	12
2.3 长鑫科技在服务器、移动设备、个人电脑等领域与国际竞争对手相比，主流产品型号均已实现量产	13
3 长鑫科技研发团队行业经验丰富，聚焦先进 DRAM 产品研发	14
3.1 公司重视研发投入，募资重点投入存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM 技术升级、存储器前瞻技术研究	14
3.2 公司核心技术人员和高管拥有丰富的行业经验，攻坚克难助力长鑫科技实现 DRAM 芯片领域从技术跟随到自主创新的关键跨越	15
3.3 合肥国资是长鑫科技早期成长及长期发展的关键投资人，在企业亏损期给予坚定的战略定力	16
4 一周科技行业要闻	17
风险提示：	18



图表目录

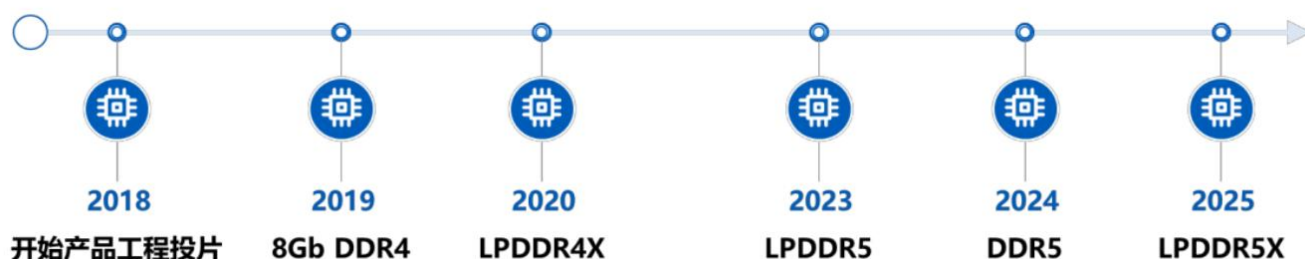
图表 1 长鑫科技公司主要产品的演变情况	5
图表 2 2025 年第一季度至 2026 年第一季度全球 DRAM 收入市场份额（按供应商划分）	5
图表 3 长鑫科技公司 DRAM 产品（DDR+LPDDR）	6
图表 4 长鑫科技 DRAM 模组产品	6
图表 5 长鑫科技公司主营业务收入的构成（单位：万元）	7
图表 6 长鑫科技公司不同应用领域在产品收入金额及占比具体情况（单位：万元）	7
图表 7 长鑫科技主要 DRAM 产品的单位价格及销量(按容量)变动幅度情况	8
图表 8 长鑫科技公司主营业务毛利率情况	8
图表 9 长鑫科技公司与可比上市公司综合毛利率对比情况	9
图表 10 长鑫科技公司与主要竞争对手在 DRAM 业务方面的比较情况	9
图表 11 长鑫科技 DRAM 产品技术（技术均为自主研发，实现国际先进技术水平）	10
图表 12 长鑫科技部分主要客户	11
图表 13 2025 年全球半导体、集成电路和存储芯片市场份额	11
图表 14 DRAM 主要分类及应用	12
图表 15 2025-2030 年 DRAM 下游应用市场需求占比	12
图表 16 2025-2030 年全球服务器 DRAM 搭载量(MGB)(左轴搭载量，右轴增长率)	12
图表 17 2025-2030 年全球移动设备 DRAM 搭载量(MGB)	13
图表 18 2025-2030 年全球个人电脑 DRAM 搭载量(MGB)	13
图表 19 长鑫科技与同行业企业产品对比（服务器领域）（已量产则“√”）	13
图表 20 长鑫科技与同行业企业产品对比（移动设备及其他消费电子领域）（已量产则“√”）	13
图表 21 长鑫科技与同行业企业产品对比（个人电脑领域）（已量产则“√”）	13
图表 22 长鑫科技主要募集资金投入项目	14
图表 23 长鑫科技主要募集资金项目投入建设周期和具体投资概算情况	14
图表 24 长鑫科技公司正在从事的主要研发项目及其进展情况	15
图表 25 长鑫科技核心技术人员取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况、对公司研发的具体贡献	16
图表 26 长鑫科技股权结构	17
图表 27 DRAM 和 NAND Flash 产值预估（2023-2027）	17
图表 28 NAND Flash 前五大品牌商营收排名 2026 年第一季	18

1 长鑫科技：我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM IDM 企业

1.1 历经十载发展风雨兼程，长鑫科技实现 DRAM（包括 HBM 和普通 DRAM）市场份额中国第一，全球第四

长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。自 2016 年成立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。公司于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 等产品覆盖和迭代升级，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。

图表 1 长鑫科技公司主要产品的演变情况

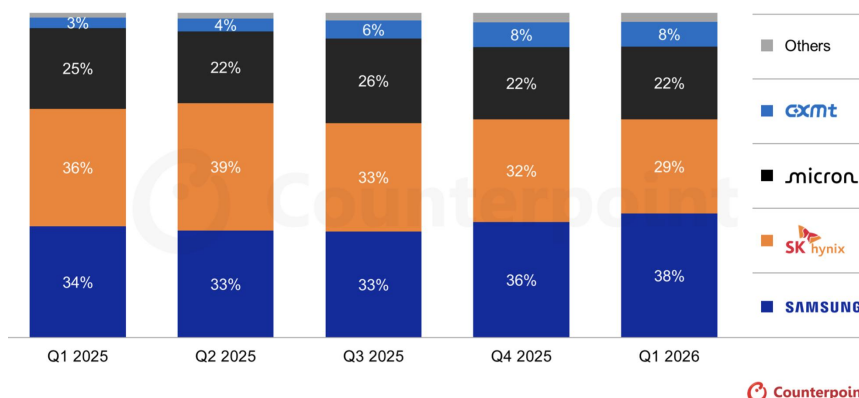


资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

我国是全球最大的 DRAM 需求市场之一，而全球前三家 DRAM 厂商三星电子、SK 海力士和美光科技长期占全球 90% 以上的市场份额。公司致力于持续扩充产能，不断提升全球市场份额，并为我国 DRAM 市场提供稳定的供应。公司在合肥、北京两地共拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂。根据 Omdia 的数据，按出货量和销售额统计，公司已成为中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。

市场占有率方面，根据 Counterpoint 的数据统计显示，长鑫科技充分受益于人工智能的增长，实现量价齐升，2026 年长鑫存储一季度 DRAM 销售收入达 73.09 亿美元，环比增长 115.1%，同比增长超过 700%，巩固了其作为第四大供应商的地位，市场份额翻倍以上增长，达到 8%。

图表 2 2025 年第一季度至 2026 年第一季度全球 DRAM 收入市场份额（按供应商划分）



资料来源：Counterpoint Research，华安证券研究所

1.2 公司产品覆盖 DDR、LPDDR 两大主流系列，提供当前市场主流的第四代、第五代产品

公司产品覆盖 DDR、LPDDR 两大主流系列，并且各系列均能提供当前市场主流的第四代、第五代产品，包括 DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X 等，产品广泛应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场领域。公司可结合不同产品的应用特点和不同客户的需求，提供 DRAM 晶圆、DRAM 芯片、DRAM 模组等多元化的产品方案，其中 DRAM 芯片是报告期内公司出货及销售的主要产品类型。凭借丰富的产品布局和卓越的产品性能，公司能够为客户提供全面的 DRAM 存储解决方案。

图表 3 长鑫科技公司 DRAM 产品 (DDR+LPDDR)

系列	产品类型	产品介绍	产品图示
DDR	DDR4	提供 8Gb 或 16Gb 的容量选择，速率可达 3200Mbps，并提供 4bit/8bit/16bit 不同位宽选择；可用于制造 8GB/16GB/32GB/64GB 等多种容量规格的 DDR4 模组	服务器、台式电脑、笔记本电脑、其他消费类产品
	DDR5	具备 16Gb、24Gb、32Gb 的容量，速率可达 8000Mbps，并可提供 4bit/8bit/16bit 等不同位宽选择；可用于制造 8GB/16GB/32GB/64GB/96GB/128GB 等多种容量规格的 DDR5 模组	
LPDDR	LPDDR4X	采用 LVSTL 的低功耗接口及多项降低功耗的设计，具备低功耗的特点。可提供 8GB 以下、8GB、12GB、16GB 等不同容量规格的产品，速率可达 4266Mbps，广泛用于移动设备等领域	手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备及其他消费类产品
	LPDDR5/5X	具备 6GB、8GB、12GB、16GB 等多种容量规格，速率可达 10667Mbps。通过内置纠错码等技术，能够有效减少系统故障，增强稳定性，广泛应用于中高端移动设备市场	

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

公司基于自身原厂 DRAM 芯片生产制造的 DRAM 模组包括 DDR4、DDR5 系列，涵盖 RDIMM、MRDIMM、UDIMM/CUDIMM、SODIMM/CSODIMM、LPCAMM 等不同类型产品。其中 RDIMM 和 MRDIMM 主要应用于服务器领域，UDIMM/CUDIMM 主要应用于计算机工作站、台式电脑，SODIMM/CSODIMM 主要应用于笔记本电脑、一体机主机中，LPCAMM 主要应用于高性能笔记本电脑、移动工作站等。公司 DDR4 模组包含 8GB/16GB/32GB/64GB 等多种容量规格，速率可达 3200Mbps。

DDR5 模组包含 8GB/16GB/32GB/64GB/96GB/128GB 等多种容量规格，速率可达 8000Mbps 及以上。

图表 4 长鑫科技 DRAM 模组产品

产品系列	产品类型	产品图示	主要应用领域
RDIMM	DDR4		服务器等
	DDR5		
MRDIMM	DDR5		计算机工作站、台式电脑等
UDIMM	DDR4		
	DDR5		
CUDIMM	DDR5		笔记本电脑、一体机主机等
SODIMM	DDR4		
	DDR5		
CSODIMM	DDR5		高性能笔记本电脑、移动工作站等
LPCAMM	LPDDR5X		

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

2023 年-2025 年，公司主营业务收入分别为 906,314.37 万元、2,392,875.14 万元和 6,127,537.21 万元。公司主要 DRAM 产品包括 DDR 系列、LPDDR 系列产品，各期主要 DRAM 产品收入占主营业务收入比例分别为 94.70%、96.00%和 98.30%，是公司收入的主要来源。

2023 年-2025 年，公司其他产品及服务销售收入占主营业务收入比例分别为 5.30%、4.00%和 1.70%，主要为提供技术及研发服务、晶圆代工及配套光罩销售收入等。

2023 年-2025 年，公司 LPDDR 系列产品销售占比较高，主要原因为 LPDDR 系列产品主要应用于智能手机和平板电脑等领域，公司在报告期内迅速拓展了相关领域的下游终端客户，客户对公司产品认可度较高，需求旺盛且增长迅速。2024 年，LPDDR 系列产品收入占比提升，主要由于公司 LPDDR5 产品于 2023 年开始量产，2024 年收入迅速增长，带动 LPDDR 系列产品销售占比提升。2024 年底，公司 DDR5 产品量产，并于 2025 年开始迅速放量，带动 DDR 系列产品的收入占比提升。

图表 5 长鑫科技公司主营业务收入的构成（单位：万元）

项目	2023		2024		2025	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	182,716.69	20.16%	317,397.33	13.26%	1,953,128.56	31.87%
LPDDR 系列	675,607.25	74.54%	1,979,825.86	82.74%	4,070,354.50	66.43%
其他产品及服务	47,990.43	5.30%	95,651.94	4.00%	104,054.15	1.70%
合计	906,314.37	100%	2,392,875.14	100%	6,127,537.21	100%

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

长鑫科技核心收入主要来自移动设备领域和服务器领域。公司产品收入主要来自于移动设备领域，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月，各期收入占 DDR、LPDDR 产品合计收入的比例分别为 71.83%、64.62%、76.77%和 64.43%，主要系公司产品以 LPDDR 系列为主，相较于 DDR 系列产品主要应用于服务器、个人电脑等领域，LPDDR 系列产品以其低功耗的特点主要应用于手机、平板电脑等移动设备领域。

服务器领域公司的产品收入和占比快速增长，2024 年和 2025 年 1-6 月，实现收入分别为 192,676.09 万元和 352,338.87 万元，占 DDR、LPDDR 产品合计收入的比例分别为 8.39%和 23.72%，主要受益于数据中心等基础设施建设需求持续快速增长，公司把握行业发展趋势推出 DDR5 等更新代际产品并快速实现客户导入。

图表 6 长鑫科技公司不同应用领域的产品收入金额及占比具体情况（单位：万元）

项目	2022 年度		2023 年度		2024 年度		2025 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
服务器	18,905	2.40%	39,451	4.60%	192,676	8.39%	352,338	23.72%
移动设备	566,869	71.83%	554,640	64.62%	1,763,520	76.77%	957,004	64.43%
个人电脑	6,172	0.78%	44,308	5.16%	36,513	1.59%	33,111	2.23%
智能汽车	3.3	0.00%	55.7	0.01%	17,645.4	0.77%	1,719.1	0.12%
其他	197,193	24.99%	219,867	25.62%	286,868	12.49%	141,056	9.50%

资料来源：关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市预先审阅申请文件的问询函的回复，华安证券研究所

1.3 2023 年-2025 年长鑫科技产品呈现销量、单价和毛利率快速上升趋势，公司主力产品与竞争对手相当

销量方面，2023 年-2025 年，公司产能处于持续建设状态，DRAM 产品销量快速增长，DDR 系列和 LPDDR 系列的销量复合增长率分别高达 107.16%和 76.93%，均呈现快速上升趋势。

单价方面，DRAM 行业在 2023 年上半年深度下行，随着行业逐步回暖及公司产品结构优化，2024 年公司产品均价整体回升。2025 年，随着公司单价较高的 DDR5 和 LPDDR5X 产品快速放量及收入占比迅速提升，同时得益于 2025 年下半年以来全球算力需求的快速增长和全球主要厂商产能调配导致的 DRAM 供给紧张，公司 DDR 系列和 LPDDR 系列产品单价进一步显著上升。

图表 7 长鑫科技主要 DRAM 产品的单位价格及销量(按容量)变动幅度情况

产品类别	项目	2023 年度	2024 年度	2025 年度
DDR 系列产品	单位价格	-46.61%	54.72%	61.00%
	销量(按容量)	132.05%	12.28%	282.22%
	营业收入	23.89%	73.71%	515.36%
LPDDR 系列产品	单位价格	-42.74%	54.63%	24.46%
	销量(按容量)	83.87%	89.51%	65.18%
	营业收入	5.29%	193.04%	105.59%

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

毛利率方面，2023 年-2025 年，不考虑存货跌价准备转销因素，公司主要 DRAM 产品销售毛利率分别为-118.69%、-4.77%及 38.75%，呈现快速上升趋势。

2023 年公司毛利率水平较低，主要由于 DRAM 行业 2023 年上半年处于深度下行周期，尽管下半年行业开始回暖，但当年公司产品价格整体较低并对毛利率产生较大冲击。2024 年以来公司毛利率持续上升，主要系公司产品单价随着 DRAM 行业逐步回暖及公司产品结构优化而提升，同时公司产品的单位成本随着公司规模效应逐步显现及精益生产管理等而下降。2025 年，在 DRAM 行业市场价格快速上涨的背景下，随着公司规模效应的持续显现，公司主要 DRAM 产品毛利率转正并实现大幅提升。

图表 8 长鑫科技公司主营业务毛利率情况

项目	2023 年度		2024 年度		2025 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
DDR 系列	-108.76%	20.16%	-26.87%	13.26%	41.89%	31.87%
LPDDR 系列	-121.37%	74.54%	-1.23%	82.74%	37.25%	66.43%
其他产品及服务	-16.29%	5.30%	-3.38%	4.00%	-17.23%	1.70%
合计	-113.27%	100%	-4.72%	100%	37.80%	100%

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

2023 年-2025 年，不考虑存货跌价准备转销因素，公司综合毛利率分别为-112.71%、-4.03%及 37.81%，2023 年和 2024 年低于可比公司平均水平，一方面是公司与中芯国际、台积电等代工企业的经营模式不同，同时与华润微的产品类型存在较大差异；另一方面主要由于公司尚处于产能快速爬坡期，与三星电子、SK 海力士、美光科技和南亚科技等 DRAM 领域的 IDM 公司所处发展阶段不同，公司折旧及摊销金额较大，产品生产成本较高，规模效应尚未完全显现。2025 年，随着公司规模效应持续显现及产品结构持续优化，同时得益于 2025 年 DRAM 产品价格大幅上涨，公司综合毛利率已转正并大幅提升，与三星电子综合毛利率基本相当，并显著高于南亚科技。

从毛利率的变动趋势看，受 DRAM 行业在下行周期后快速回暖和市场供需格局变化等因素的影响，公司毛利率呈现快速上升趋势，与美光科技、SK 海力士等 DRAM 领域的 IDM 公司基本一致。

图表 9 长鑫科技公司与可比上市公司综合毛利率对比情况

公司简称	2023 年度	2024 年度	2025 年度
三星电子	30.33%	37.99%	39.38%
SK 海力士	-1.63%	48.08%	60.41%
美光科技	-9.11%	22.35%	39.79%
南亚科技	-15%	-1.23%	22.51%
台积电	54.36%	56.12%	59.89%
中芯国际	21.89%	18.59%	21.62%
华润微	32.22%	27.19%	26.38%
平均值	16.15%	29.87%	38.57%
长鑫科技(转销前)	-112.71%	-4.03%	37.81%
长鑫科技	-1.93%	5.58%	40.99%

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

注 1:资料来源为可比上市公司定期报告，美光科技财年与日历年不一致，按照财年口径计算。

注 2:转销前数据为不考虑存货跌价准备转销影响的口径。

长鑫科技公司主要竞争对手为国际前三家 DRAM 厂商，包括三星电子、SK 海力士以及美光科技。其中，三星电子是一家综合性电子产品的生产和销售企业，从收入结构来看，2024 财年三星电子存储产品收入占比为 28%。

SK 海力士和美光科技主要从事半导体存储生产及销售，主要产品包括 DRAM、NANDFlash 等，从收入结构来看，2024 财年 SK 海力士 DRAM、NANDFlash 及其他收入占比分别为 68%、29%和 3%；

2024 财年美光科技 DRAM、NANDFlash 及其他收入占比分别为 70%、29%和 1%。

在产品布局与迭代方面，长鑫科技公司在产品种类和丰富度上较主要竞争对手有一定差距。公司已在占据 DRAM 市场出货量 90%以上的 DDR、LPDDR 产品领域深度布局，但与国际前三家 DRAM 厂商相比产品系列相对更少。在 DDR、LPDDR 系列产品方面，公司产品已迭代至当前主流的 DDR5、LPDDR5/5X，与主要竞争对手基本相当。在下游应用领域方面，长鑫科技公司产品主要下游应用领域和主要客户类型上与国际竞争对手不存在实质差异。公司 DDR、LPDDR 产品广泛应用于服务器、个人电脑、移动终端等领域，与主要竞争对手不存在实质差异。

图表 10 长鑫科技公司与主要竞争对手在 DRAM 业务方面的比较情况

项目	长鑫科技	三星电子	SK 海力士	美光科技
主力产品及迭代情况	DDR5 LPDDR5/5X	DDR5 LPDDR5X GDDR7 HBM3E	DDR5 LPDDR5T/5X GDDR7 HBM3E	DDR5 LPDDR5X GDDR7 HBM3E
应用领域	服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等	服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车、其他消费电子、工控等		

资料来源：关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市预先审阅申请文件的问询函的回复，华安证券研究所

在产能规模方面，公司产能规模已位居中国第一、全球第四，但距离国际前三家 DRAM 厂商仍有一定差距。国际前三家厂商凭借自上世纪 80 年代以来的长期产能扩张与整合，占市场主导地位。公司业务发展起步相对较晚，目前公司处于大规模产能建设与爬坡阶段，截至 2025 年 6 月末，公司产能规模已位居中国第一、全球第四，仅次于三星电子、SK 海力士和美光科技；随着公司规划产能持续建设和爬坡，未来公司产能规模将继续保持增长，并有望进一步缩小与主要竞争对手的差距。

1.4 公司拥有核心技术，产品受到头部客户认可

长鑫科技公司深耕 DRAM 存储芯片的设计与制造，通过持续的研发投入与技术探索，已掌握了多项达到国际先进水平的工艺和产品核心技术，覆盖 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利(其中发明专利 3,165 项)以及 3,043 项境外专利。公司核心技术主要为自主研发形成，公司研发团队通过研发与创新形成了现有核心技术平台，并已大量应用于公司产品的大批量生产中。

图表 11 长鑫科技 DRAM 产品技术（技术均为自主研发，实现国际先进技术水平）

核心技术名称		产品技术特征及先进性表征
1	DDR4 设计技术	1、可实现数据独立读写提升数据吞吐量的两组 Bank Group 技术； 2、可降低芯片功耗的温度控制刷新、温度补偿自刷新等技术。
2	DDR5 设计技术	1、信道反馈均衡技术，提升高速内存接口的数据接收裕量； 2、更优化的算法及保护电路，提升数据的安全性，降低 Row Hammer 的风险； 3、先进的封装工艺如 RDL 和后段金属，提高电源完整性；在内存条上，引入了专门的电源管理芯片以进一步保证电源的性能； 4、引入了纠错功能（ECC），提升了系统的可靠性； 5、四组 Bank Group 设计，进一步提高了内存的并行性和访问效率及带宽。
3	LPDDR4X 设计技术	1、16 倍数据预取技术，提升内存的整体效率和带宽； 2、片上纠错功能（ECC），从而提升系统的可靠性； 3、开发 DDP、QDP、6DP、8DP 等多种封装形式，满足客户不同应用场景需求； 4、温度补偿刷新技术，在不同温度使用不同刷新频率，从而降低刷新功耗； 5、低功耗电源管理系统，在芯片不同工作模式下提供不同的电源能力，从而降低待机模式下的功耗。
4	LPDDR5/5X 设计技术	1、信道反馈均衡技术，提升高速内存接口的数据接收裕量； 2、电源电压随频率动态调整（DVFS）的技术，以进一步降低功耗； 3、更优化的算法及保护电路，提升系统的可靠性，降低 Row Hammer 的风险； 4、先进的封装工艺如 RDL 和后段金属，提高电源完整性； 5、Bank Group 设计，提升了数据访问的效率及带宽。
5	DRAM 产品封装技术	1、多层芯片堆叠 PoP 封装技术； 2、实现内存芯片和闪存芯片容量灵活搭配的 uPoP 封装技术； 3、FlipChip 半导体晶片倒装封装技术。
6	DRAM 模组设计技术	1、RDIMM/UDIMM/SODIMM 内存模组产品技术，广泛应用于服务器，台式机和笔记本电脑，为整个系统提供内存存储； 2、LPCAMM（低电压压接式内存模组）新型内存模组产品技术，应用于工作站和游戏类高性能笔记本电脑； 3、MRDIMM（多重存取内存模组）新型内存模组产品技术，实现双倍的数据传输速率。

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

作为 DRAM 产业龙头企业，经过长期发展，长鑫科技公司已与上下游合作伙伴共同构建了相互依存、共同发展的产业生态。公司在服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等各大领域积累了广泛的优质客户资源，建立了良好的品牌效应。

公司与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业核心客户开展了深度合作，持续赢得客户的肯定和赞誉。

图表 12 长鑫科技部分主要客户



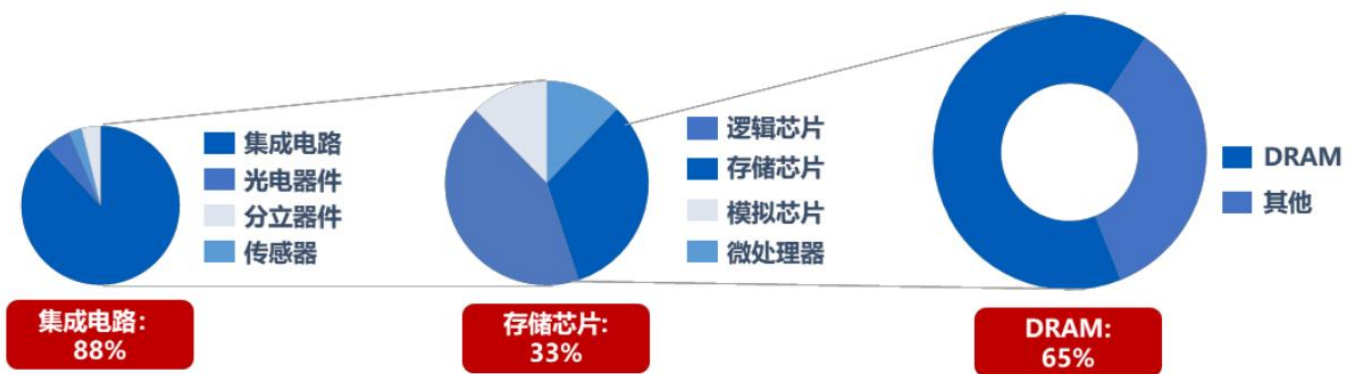
资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所绘制

2 DRAM 是人工智能算力系统的核心枢纽，随基础设施投资而增长

2.1 DRAM 是全球半导体市场占比最高且增速最高的单一品类之一

作为数字经济时代新型信息基础设施的核心组成部分，DRAM 在现代信息社会中扮演着战略性基础设施的重要角色，是全球半导体市场占比最高的单一品类之一。根据世界半导体贸易统计协会 WSTS 统计，2025 年全球集成电路市场规模为 7,009 亿美元，占半导体产业整体规模的比例约为 88%，其中，全球存储芯片市场规模为 2,300 亿美元，占集成电路市场规模的比例约为 33%。根据 Omdia 和 WSTS 数据，DRAM 是市场规模最大的存储芯片，2025 年全球 DRAM 市场规模为 1,505 亿美元，占存储芯片市场规模的比例约为 65%。

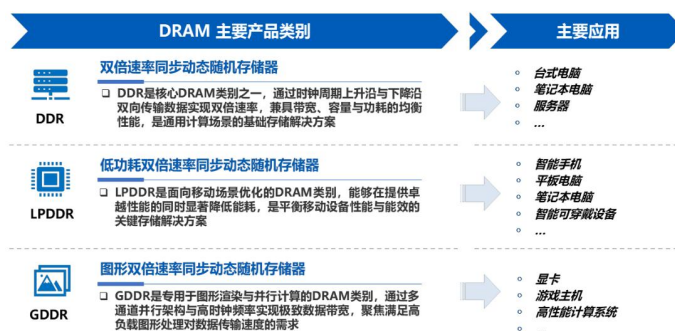
图表 13 2025 年全球半导体、集成电路和存储芯片市场份额



资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，WSTS，Omdia，华安证券研究所

在 DRAM 发展过程中，DRAM 产品类型主要分为 DDR(双倍速率同步动态随机存储器)、LPDDR(低功耗双倍速率同步动态随机存储器)、GDDR(图形双倍速率同步动态随机存储器)和其他新型高端存储器等。其中，DDR 及 LPDDR 产品面向广泛的下游终端应用领域，是 DRAM 市场的重要组成部分。主流 DRAM 以容量大、传输速率高为特点，主要应用于服务器、移动设备、个人电脑等市场领域，下游市场具有市场规模大、技术要求高的特点。

图表 14 DRAM 主要分类及应用



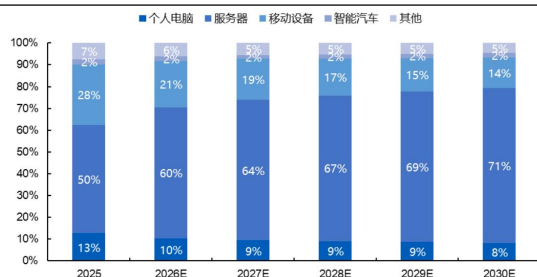
资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

2.2 服务器、移动设备、个人电脑和智能汽车构成 DRAM 主要应用领域，服务器复合增速最快

根据 Omdia 统计，2025 年全球 DRAM 下游应用领域中，服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车市场需求占比分别约为 50%、28%、13%和 2%，前述四大应用市场合计占全球 DRAM 下游应用需求市场的比例超过 90%。

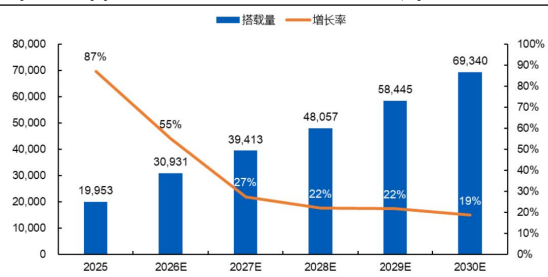
服务器 DRAM 有望成为 DRAM 各应用领域中增长最快的市场之一。根据 Omdia 数据，2025 年全球服务器 DRAM 市场占比约为 50%，到 2030 年服务器 DRAM 市场占比预计将增长至约 71%。数据中心扩张、云计算发展对于数据处理基础设施建设的需求持续快速增长，成为服务器 DRAM 市场规模扩大的核心驱动力之一。根据 Omdia 预测，全球服务器搭载的 DRAM 总量预计将由 2025 年的约 19,953 MGB 增长至 2030 年的约 69,340 MGB，2025-2030 年年复合增长率约为 28.29%。

图表 15 2025-2030 年 DRAM 下游应用市场需求占比



资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，Omdia，华安证券研究所

图表 16 2025-2030 年全球服务器 DRAM 搭载量 (MGB)(左轴搭载量，右轴增长率)

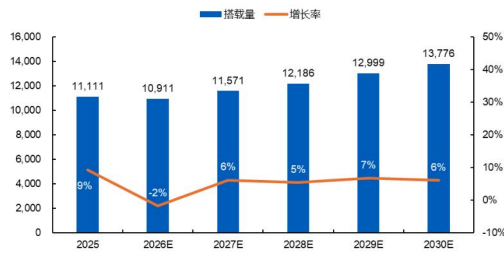


资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，Omdia，华安证券研究所

移动设备 DRAM 是 DRAM 核心下游应用市场之一，其中智能手机应用在移动设备 DRAM 市场中占有主要份额，其余细分应用包括平板电脑等。移动设备性能提升及功能升级驱动单机内存容量增长，为移动设备 DRAM 需求提供有力支撑，推动其市场规模稳健增长。根据 Omdia 预测，全球移动设备搭载的 DRAM 2025-2030 年年复合增长率约为 4.39%。

个人电脑 DRAM 是 DRAM 第三大应用市场，主要应用包含台式机和笔记本电脑等。个人电脑的换机升级以及端侧场景的持续拓展，成为驱动个人电脑 DRAM 市场增长的重要因素。根据 Omdia 预测，全球个人电脑搭载的 DRAM 2025-2030 年年复合增长率约为 9.07%。

图表 17 2025-2030 年全球移动设备 DRAM 搭载量 (MGB)



资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，Omdia，
华安证券研究所

图表 18 2025-2030 年全球个人电脑 DRAM 搭载量 (MGB)



资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，Omdia，
华安证券研究所

2.3 长鑫科技在服务器、移动设备、个人电脑等领域与国际竞争对手相比，主流产品型号均已实现量产

在服务器领域，长鑫科技在 32GB 及以下和 32GB 以上的 DDR4 产品均实现量产；在 DDR5 领域，长鑫科技在 64GB 以下，64GB 和 64GB 以上的产品均实现量产。在移动设备及其他消费电子领域，长鑫科技在 LPDDR4X 方面，8GB 以下、8GB 和 8GB 以上均实现量产；在 LPDDR5/5X 方面，16GB 以下，16GB 和 16GB 以上均实现量产。在个人电脑领域，长鑫科技在 DDR4 方面，8GB 及以下和 8GB 以上均实现量产；在 DDR5 方面，长鑫科技实现 16GB 以下，16GB 和 16GB 以上产品实现量产。

图表 19 长鑫科技与同行业公司产品对比（服务器领域）（已量产则“√”）

公司简称	DDR4			DDR5	
	32GB 及以下	32GB 以上	64GB 以下	64GB	64GB 以上
三星电子	√	√	√	√	√
SK 海力士	√	√	√	√	√
美光科技	√	√	√	√	√
南亚科技	√	√	√	开发中	开发中
长鑫科技	√	√	√	√	√

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

图表 20 长鑫科技与同行业公司产品对比（移动设备及其他消费电子领域）（已量产则“√”）

公司简称	LPDDR4X			LPDDR5/5X		
	8GB 及以下	8GB	8GB 以上	16GB 以下	16GB	16GB 以上
三星电子	√	√	√	√	√	√
SK 海力士	√	√	√	√	√	√
美光科技	√	√	√	√	√	√
南亚科技	√	/	/	开发中	/	/
长鑫科技	√	√	√	√	√	√

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

图表 21 长鑫科技与同行业公司产品对比（个人电脑领域）（已量产则“√”）

公司简称	DDR4			DDR5		
	8GB 及以下	8GB 以上	16GB 以下	16GB	16GB 以上	
三星电子	√	√	√	√	√	
SK 海力士	√	√	√	√	√	
美光科技	√	√	√	√	√	
南亚科技	√	√	√	√	√	
长鑫科技	√	√	√	√	√	

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

3 长鑫科技研发团队行业经验丰富，聚焦先进 DRAM 产品研发

3.1 公司重视研发投入，募资重点投入存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM 技术升级、存储器前瞻技术研究

长鑫科技本次 IPO 拟募集资金总额 295 亿元，计划投向三大方向：存储器晶圆制造量产线技术升级改造（75 亿元）、DRAM 存储器技术升级（130 亿元）、动态随机存取存储器前瞻技术与开发（90 亿元）。

图表 22 长鑫科技主要募集资金投入项目

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目	75	75	发行人子公司
2	DRAM 存储器技术升级项目	180	130	发行人子公司
3	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目	90	90	发行人
	合计	345	295	-

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

图表 23 长鑫科技主要募集资金项目投入建设周期和具体投资概算情况

项目	项目概况	项目周期	时间进度	项目投资主要情况
存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目	逐步实现向中高端产品生产线的工艺技术的切换，包括刻蚀、薄膜沉积、清洗等工艺步骤的技术升级改造，完成工艺产品线的改造升级。	项目建设周期为 3 年	于 2025 年三季度前完成项目的初步设计、施工图设计，于 2027 年底前分批实施厂务改造、机台搬入、机台调试、机台投产等工作，于 2028 年上半年前完成竣工验收。	建筑工程费，投入金额 3.34 亿，占比 4.45%； 设备购置及安装费，投入金额 46.66 亿，占比 62.22%； 无形资产，投入金额 25 亿，占比 33.33%。
DRAM 存储器技术升级项目	包括刻蚀、薄膜沉积、清洗等工艺步骤的技术改造升级，核心升级内容包括工艺提升、产品迭代等。通过实施本项目，将发行人子公司提升至更新一代工艺技术平台。	项目建设周期为 3 年	于 2025 年三季度前，完成项目前期工作，包括项目的初步设计、产能规划和设备需求规划，从 2025 年第四季度开始启动设备购买计划，计划于 2026 年到 2027 年底前分批实施设备搬入、设备调试等工作，于 2028 年上半年前完成竣工验收。	设备购置及安装费，投入 174 亿，占比 96.67%； 预备费，投入 6 亿，占比 3.33%。
动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目	聚焦适配于未来先进 DRAM 所需要的前瞻技术研究，公司将以市场和客户需求趋势为基础，基于 DRAM 未来前沿技术发展方向，对适配 DRAM 的前瞻技术开展研发工作。	项目建设周期为 3 年	计划于 2026 年 12 月前，完成引入新机台的调试，实现适配 DRAM 的前瞻技术平台的工艺流程搭建工作；2027 年 12 月前，完成前瞻技术平台工艺平台与工艺开发的结构搭建与验证，并进行技术平台工艺流程的优化工作；2028 年 12 月前，完成前瞻技术平台工艺与架构的完善，验证并提取出器件的关键电学特性工作。	项目投资总额为 90.00 亿元，主要包括研发人员费用、固定资产投资、材料与备件及其他费用、测试与服务等。

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

公司目前正在从事的主要研发项目包括第四代工艺技术平台及相关产品研发项目、第五代工艺技术平台及相关产品研发项目和预研项目及其他。其中第五代工艺技术平台及相关产品研发项目中，研发目标为采用进一步优化的多重曝光技术，进一步提升存储密度和阵列性能。

图表 24 长鑫科技公司正在从事的主要研发项目及其进展情况

序号	研发项目名称	研发目标	项目进展情况	技术来源	参与研发人员
1	第四代工艺技术平台及相关产品研发项目	基于第四代技术平台，开发容量更大、性能更高的 LPDDR4X 产品、DDR5 产品和 LPDDR5X 产品，以满足服务器、手机、个人电脑等市场需求	工艺改进研发和更大容量、更高性能的产品研发	自主研发	发行人研发团队
2	第五代工艺技术平台及相关产品研发项目	采用进一步优化的多重曝光技术，进一步提升存储密度和阵列性能	研发阶段	自主研发	发行人研发团队
3	预研项目及其他	建立未来的 DRAM 技术平台并开发面向未来市场应用的相关产品及技术，能够基于技术平台设计满足行业 JEDEC 标准的更高密度 LPDDR5X、LPDDR6、DDR5 等产品，实现更高密度、更高容量、更高速度、更低功耗，满足服务器、移动设备和个人电脑等市场内存需求	研发阶段	自主研发	发行人研发团队

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

3.2 公司核心技术人员和高管拥有丰富的行业经验，攻坚克难助力长鑫科技实现 DRAM 芯片领域从技术跟随到自主创新的关键跨越

朱一明先生，2005 年创办兆易创新，2005 年 4 月至 2018 年 7 月，任兆易创新总经理；2005 年 4 月至今，任兆易创新董事长。2018 年 7 月至 2023 年 4 月，先后任长鑫存储董事、董事长、首席执行官；2020 年 5 月至 2023 年 4 月，任长鑫科技首席执行官；2021 年 2 月至今，任长鑫科技董事长。

曹堪宇先生，博士研究生。2002 年 5 月至 2005 年 6 月，曹堪宇先生先后曾任职于美国飞利浦半导体股份有限公司、美国 Hyper bandcomm 公司；2005 年 7 月至 2013 年 8 月先后创立了北京昆天科微电子有限公司、北京凡达讯科技有限公司；2013 年 11 月至 2017 年 10 月，任 NoVoMem, Inc. NAND 闪存事业部总经理。2017 年 11 月加入发行人后，先后任睿力集成执行副总裁、长鑫存储产品研发执行副总裁、技术研发执行副总裁、长鑫集电总经理等职务；2021 年 6 月至今，任发行人董事；2023 年 4 月至今，先后任长鑫科技首席执行官、总裁。

李红文先生，1998 年 9 月至 2003 年 3 月，先后任职于中国航空计算技术研究所第十研究室、北京高鸿信通技术有限公司、北京畅迅信通技术有限公司；2003 年 3 月至 2017 年 2 月，任美光半导体(上海)有限责任公司设计部经理。2017 年 3 月加入发行人，先后任长鑫科技设计总监、长鑫存储副总裁等职务；2023 年 2 月至今，先后任长鑫科技副总裁、高级副总裁。

TAN TECK HONG(陈德鸿)先生，硕士研究生。2005 年 7 月至 2022 年 4 月，TAN TECK HONG(陈德鸿)先生任职于新加坡美光科技。2022 年 6 月加入发行人，目前担任长鑫科技工厂运营副总裁职务。

王丹女士，博士研究生。2010 年 9 月至 2018 年 3 月，王丹女士于韩国三星电子担任高级工程师职务。2019 年 1 月加入发行人，目前担任长鑫科技研发总监职务。

唐衍哲女士，博士研究生。2004 年 5 月至 2018 年 11 月，唐衍哲女士先后任职于冠捷半导体(上海)有限公司、GLOBAL FOUNDRIES、Institute of Microelectronics/A*STAR、NXP Semiconductors 等公司；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任职于绿芯存储技术有限公司，担任总监职务。2020 年 11 月加入长鑫科技，目前担任长鑫科技总监职务。

图表 25 长鑫科技核心技术人员取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况、对公司研发的具体贡献

姓名	核心技术人员主要贡献
曹堪宇	拥有 20 余年半导体行业经验，是中国 DRAM 产业的重要推动者。2017 年加入长鑫科技以来，曹堪宇先生主导制定了公司研发战略和技术路线图，带领团队成功开发第三代和第四代自主工艺技术平台，实现 DDR4/LPDDR4X、DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 存储芯片从设计到量产的完整突破，填补了国内相关产品和技术的空白。 作为公司技术带头人，曹堪宇先生推动器件模型、电路设计、产品测试等全流程研发工作，完成 DRAM 产品技术开发及量产应用。曹堪宇先生拥有多项授权发明专利，发表多篇学术论文，是国家科技部、工信部专家库成员，2023 年获评首届“国家卓越工程师”称号。在曹堪宇先生的领导下，公司构建了完整的技术创新体系，为中国存储芯片产业实现技术自主化和市场国际化做出重要贡献，更标志着中国企业在全球 DRAM 芯片领域实现了从技术跟随到自主创新的关键跨越。
李红文	2020 年以来，李红文先生带领产品开发团队和工艺开发部门紧密合作，实现测试芯片在第三代工艺技术平台的流片、产品工程送样、量产等工作。随后，李红文先生持续带领产品开发团队研发大容量高速率 DDR4、DDR5、LPDDR4X 及 LPDDR5/5X 产品。在公司工作期间，李红文先生作为发明人参与公司大量已授权发明专利的技术研发工作，并作为项目负责人主导多个省部级重大科研项目。
TAN TECK HONG (陈德鸿)	在担任公司晶圆厂厂长和公司运营副总裁期间，带领量产团队完成第一代和第三代工艺技术平台产品的量产工作。在第四代工艺技术平台，与产品研发团队合作进行 DDR5 和 LPDDR4X 产品的工艺改进，攻克工艺技术平台升级的技术难点，实现量产良率的提升和产能的快速爬坡。 TAN TECK HONG (陈德鸿) 先生推动完成新厂产能建设及智能工厂雏形建设，搭建了公司工厂自主可持续运营流程与标准化体系。
王丹	王丹女士在公司组建了本土的首个 DRAM 核心器件研发团队，带领团队参与并完成了第三代/第四代工艺技术平台的开发，实现了中国大陆 DRAM 从无到有的突破，并以项目总负责人的身份参与第五代工艺技术平台研发。 王丹女士作为发明人参与公司多项已授权发明专利的技术研发工作，发表多篇半导体器件及工艺研发相关论文，并参与多项国家及省部级重点科研项目。
唐衍哲	唐衍哲女士参与了公司第三代、第四代、第五代工艺技术平台及相关产品研发项目，是 DDR 系列产品的设计负责人，同时也是前沿研究项目的设计负责人。 唐衍哲女士作为发明人参与公司多项已授权专利的技术研发工作，作为项目负责人参与国家级重大科研项目，并发表多篇技术论文。唐衍哲女士曾获得全国发明专利金奖、上海市科技进步二等奖等荣誉。

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

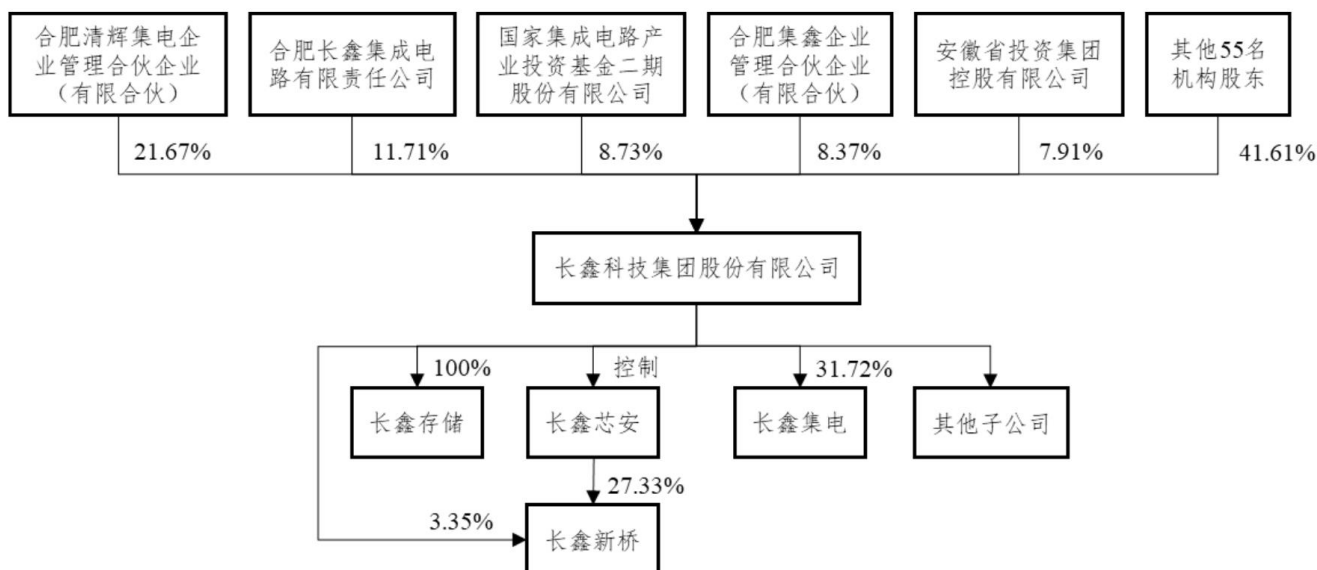
3.3 合肥国资是长鑫科技早期成长及长期发展的关键投资人，在企业亏损期给予坚定的战略定力

根据合肥发改委官方微信公众号显示，股权结构方面，发行前，长鑫科技第一大股东为清辉集电，持股比例为 21.67%。清辉集电第二大股东（持有清辉集电 48.9%）长鑫集成实控人为合肥市国资委，由合肥产投 100% 持股。另外，清辉集电第一大股东芯睿投资（持有清辉集电 51.09%）股权穿透后发现，其实控人为合肥经开区国资委。

同时，长鑫集成也是长鑫科技第二大股东，持股比例为 11.71%。长鑫集成持有财产份额的产投壹号和产投高成长均直接持股长鑫科技，持股比例分别为 1.85%、0.06%。合肥国资的身影还出现在合肥建长身上，合肥建长实控人为合肥市国资委，其持有长鑫科技 1.50% 股份。

作为陪伴长鑫科技早期成长及长期发展的关键投资人，合肥国资的持续支持，不仅为项目初期的巨额资金需求提供了保障，更在企业经历亏损期时给予了坚定的战略定力。此外，安徽省投（实控人为安徽省国资委）对长鑫科技直接持股 7.91%。大基金二期以 8.73% 持股位居长鑫科技第三大股东。

图表 26 长鑫科技股权结构



资料来源：长鑫科技集团股份有限公司招股说明书，华安证券研究所

4 一周科技行业要闻

(1) AgenticAI 刺激存储器需求扩张，预估 2027 年全球存储器产值将扩大至 1.28 万亿美元

根据 TrendForce 集邦咨询最新存储器产业研究，AI 发展从大型模型训练转向以推理为核心的 AgenticAI（代理式 AI）应用，驱动存储器需求结构性扩张，由于供给缺口短期无法补足，推升价格上涨。因此，TrendForce 集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估，将 2026 年产值从前一版的 5,516 亿美元提高至 8,893 亿美元，2027 年则预计由 8,427 亿美元上修至逾 1.28 万亿美元，年增率约 44%。（来源：TrendForce）

图表 27 DRAM 和 NAND Flash 产值预估（2023-2027）

2023-2027年DRAM与NAND Flash产值预估 (unit: US\$ billion)



Source: TrendForce, May 2026

TrendForce

资料来源：TrendForce，华安证券研究所

(2) 供不应求态势激励价格成长，1Q26 全球前五大 NAND Flash 品牌合计营收季增 83.7%

根据 TrendForce 集邦咨询最新 NAND Flash 产业调查，2026 年第一季，全球各云端服务供应商（CSP）为满足建设 AI Server 基础设施时的高速传输、大容量要求，带动 Enterprise SSD 需求呈几何倍数成长。此外，因传统 HDD 持续出现结构性缺货，促使大批订单转向 QLC Enterprise SSD。在需求爆发、供给受限的情况下，NAND Flash 原厂平均销售单价（ASP）普遍优于预期，带动第一季前五大品牌商合计营收季增 83.7%，突破 389 亿美元。

观察第二季，供需失衡格局不变，尽管智能手机与 PC 需求因存储器价格上涨和整机价格上调而受到影响，但来自 Server 端的订单将填补此一缺口。原厂普遍预期第二季 NAND Flash 出货量将继续增长，议价机制也将持续支撑 ASP 表现。

其中 Samsung（三星）受惠于季度议价机制与 Server 应用位元出货量跃升，带动 ASP 大幅成长，以 135.1 亿美元营收稳居龙头，季增幅度高达 104.7%，为前五大品牌最高，市占率也从 28% 提升至 31.6%。

TrendForce 集邦咨询表示，2026 年主要 NAND Flash 原厂几乎无新增产能，在 AI 需求持续强劲的情况下，预期全年都将呈现供给短缺态势，而 200 层以上的高层数产品也将在年底成为市场的主流。此外，产能资源将持续向 Server 应用倾斜，进一步推升大容量 QLC Enterprise SSD 的渗透率。（来源：TrendForce）

图表 28 NAND Flash 前五大品牌商营收排名 2026 年第一季

2026年第一季NAND Flash前五大品牌商营收排名

Rank	Company	Revenue (US\$M)		Market Share (%)	
		1Q26	QoQ (%)	1Q26	4Q25
1	Samsung	13,510.1	104.7%	31.6%	28.0%
2	SK hynix Group (SK hynix + Solidigm)	7,533.6	44.6%	17.6%	22.1%
3	Kioxia	5,960.0	80.0%	13.9%	14.1%
4	Micron	5,950.0	96.7%	13.9%	12.8%
4	SanDisk	5,950.0	96.7%	13.9%	12.8%
Total of Top 5		38,903.7	83.7%	90.9%	89.9%

注1：4Q25汇率均值：美元兑日圆汇率：1:154.1；美元兑韩元汇率：1:1,448.8

注2：1Q26汇率均值：美元兑日圆汇率：1:156.9；美元兑韩元汇率：1:1,465.6

Source: TrendForce, May 2026



资料来源：TrendForce，华安证券研究所

风险提示：

存储扩产进度不及预期，客户验证进度不及预期，AI 服务器发展不及预期，产品研发和技术验证不及预期，市场竞争加剧；本报告新股介绍内容不涉及证券投资研究，仅为材料梳理以供投资者方便获取信息。

分析师与研究助理简介

分析师：李美贤，华安证券电子行业首席分析师。中国人民大学硕士，2024年1月加入华安证券。曾任职于东兴证券，4年电子及通信行业研究经验。擅长海外对标复盘。

分析师：李元晨，墨尔本大学会计和金融学本科，悉尼大学数据分析和金融学硕士。2022年加入华安证券研究所，目前重点覆盖 MEMS 和传感器、AI 芯片、半导体材料设备、科创新股等。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。